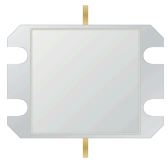
8500–9600 MHz GaN 내부 정합 전력 트랜지스터 — PSAT 51 dBm (대표값)

LCT-8500-9600-PS51T · 8500–9600 MHz · GaN 내부 정합 전력 트랜지스터.

RF 전기 특성표의 규격값: PSAT 51 dBm (대표값); 전력 이득 9 dB (대표값); PAE 38 % (대표값). RF 측정 조건: Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm.



CMW025B

게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다.

Vg: C = 10 µF

RF 특성

Vd = +28 V; Vg = -3 V; PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 42 dBm

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	8500	-	9600	MHz
포화 출력 전력	-	50	51	-	dBm
전력 이득	-	8	9	-	dB
전력 부가 효율	-	-	38	-	%
전력 이득 평탄도	-	-	-	±0.8	dB

DC 바이어스 및 전류

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
드레인 동작 전압	-	-	-	-	28	V
게이트 동작 전압	-	-	-	-	-3	V

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	-	-	-	32	V
게이트 바이어스 하한	-	-5	-	-	V
보관 온도	-	-65	-	150	°C
최대 입력 전력	-	-	-	45	dBm
최대 채널 온도	-	-	-	200	°C

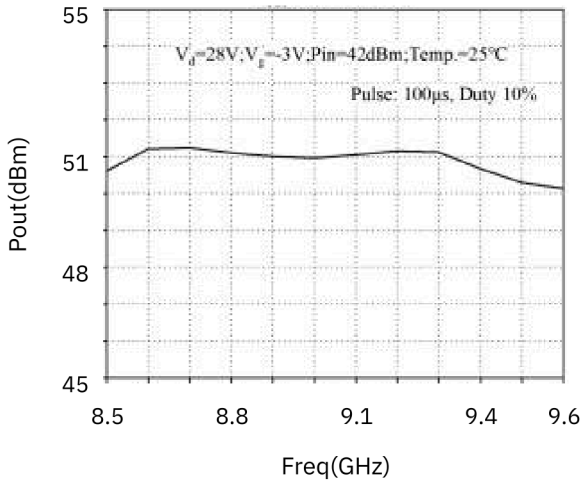
현재 발행 기록 · 1.5 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.4.

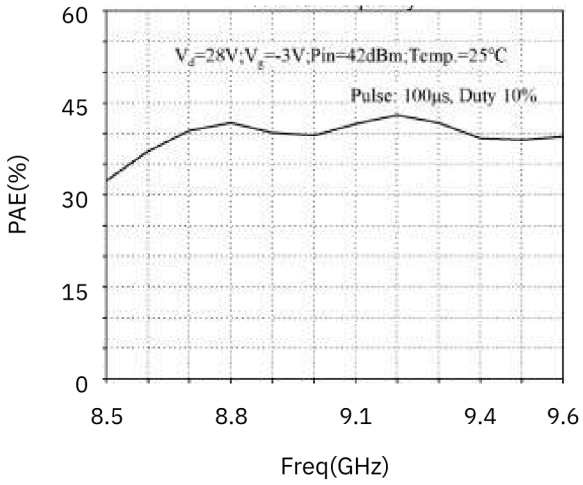
통합 설계 안내

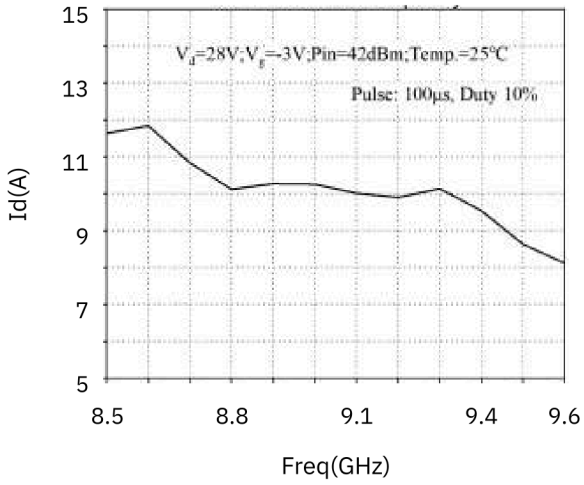
CMW025B 게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다. Vg: C = 10 µF G: RF 입력 D: RF 출력 S: 소스 / 접지

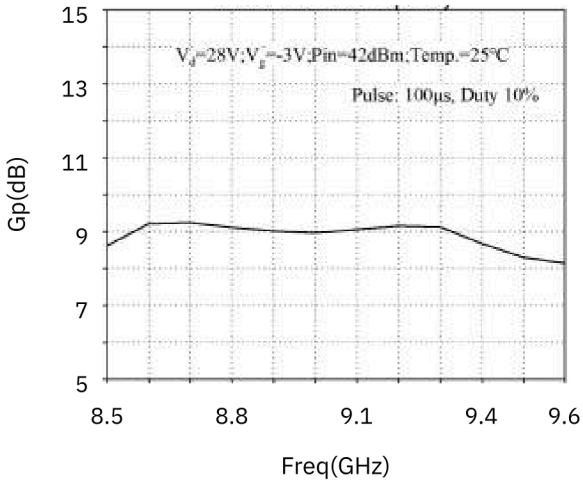
성능 특성 곡선

각 그림에 명시된 동작 조건과 함께 확인하십시오.









출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 전류; 전력 이득. Vd = 28 V; Vg = -3 V; Pin = 42 dBm; TA = 25 °C; PW = 100 μs; D = 10%.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.